

Кочкова Анастасия Ильинична

Исследование электрических характеристик и спектров глубоких центров в кристаллах и эпитаксиальных пленках β -Ga₂O₃

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Специальность **1.3.11 – «Физика полупроводников»**

Работа выполнена на кафедре полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС

Научный руководитель: к.т.н., профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ МИСИС Поляков Александр Яковлевич.

Экспертная комиссия:

1. Ховайло Владимир Васильевич - д.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ МИСИС – председатель комиссии;
2. Мухин Сергей Иванович - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ МИСИС;
3. Таперо Константин Иванович – д.т.н., старший научный сотрудник, заместитель генерального директора по науке и инновациям АО «Научно-исследовательский институт приборов», ГК «Росатом»;
4. Карасёв Платон Александрович – д.ф.-м.н., профессор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;
5. Мармалюк Александр Анатольевич – д.т.н., начальник НТЦ Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Полюс» имени М.Ф. Стельмаха», АК «Ростех».

Ведущее предприятие:

Акционерное общество «Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук»; город Черноголовка.

Защита диссертации состоится «19» июня 2023 года по адресу 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.